

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

**特許第3721156号
(P3721156)**

(45) 発行日 平成17年11月30日(2005.11.30)

(24) 登録日 平成17年9月16日(2005.9.16)

(51) Int.Cl.⁷

F I

GO2F 1/1368

GO2F 1/1368

GO2F 1/1333

GO2F 1/1333 505

GO2F 1/1335

GO2F 1/1335 500

GO2F 1/1343

GO2F 1/1335 505

GO2F 1/1343

請求項の数 1 (全 20 頁)

(21) 出願番号 特願2002-321161 (P2002-321161)
 (22) 出願日 平成14年11月5日(2002.11.5)
 (62) 分割の表示 特願平11-242226の分割
 原出願日 平成11年8月27日(1999.8.27)
 (65) 公開番号 特開2003-177429 (P2003-177429A)
 (43) 公開日 平成15年6月27日(2003.6.27)
 審査請求日 平成14年11月5日(2002.11.5)

前置審査

(73) 特許権者 303018827
 NEC液晶テクノロジー株式会社
 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地
 (74) 代理人 100109313
 弁理士 机 昌彦
 (74) 代理人 100136814
 弁理士 工藤 雅司
 (74) 代理人 100111637
 弁理士 谷澤 靖久
 (72) 発明者 吉川 周憲
 東京都港区芝五丁目7番1号
 日本電気株式会社内
 (72) 発明者 坂本 道昭
 東京都港区芝五丁目7番1号
 日本電気株式会社内
 最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

透明な第1の基板上に、走査線、ゲート電極および共通電極線を形成する工程と、これらの配線および電極を含む前記第1の基板の全面にゲート絶縁膜を形成する工程と、前記ゲート電極の上部の前記ゲート絶縁膜上に半導体層を形成した後、前記半導体層上にソース電極およびドレイン電極を形成して薄膜トランジスタを形成する工程と、前記ゲート絶縁膜上に信号線を形成する工程と、前記薄膜トランジスタ、前記信号線を含む前記第1の基板の全面にパッシベーション膜を設ける工程と、前記薄膜トランジスタの上部の前記パッシベーション膜上に遮光膜を、その他の部分の前記パッシベーション膜上にカラーフィルタを形成する工程と、前記カラーフィルタ上にオーバーコート層を形成し、前記オーバーコート層上に画素電極と共通信号が印加される共通電極とを形成するとともに、前記画素電極および前記共通電極は各画素ごとに設けられたそれぞれのコンタクトホールを介して前記ドレイン電極および前記共通電極線にそれぞれ接続する工程と、前記第1の基板と透明な第2の基板とを対向させその間に液晶を封止する工程とを含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、面内に水平な電界を用いて液晶を駆動する方式の液晶表示装置の製造方法に関する。

【 0 0 0 2 】

【 従来 の 技 術 】

液晶表示装置の液晶の動作モードとしては、基板間で液晶分子の分子軸の方向（以下、ダイレクタと呼ぶ）を上下基板間で約 90 度回転させて液晶分子をツイスト配向させ、基板に対して垂直方向の電界により、ダイレクタを垂直方向に回転させて表示を行うツイステッドネマティックモード（以下、TNモードと呼ぶ）が従来用いられてきた。

【 0 0 0 3 】

しかしながら、このTNモードは、視野角が狭いという問題点がある。その為、斜め方向から表示を視認出来ない他、大容量表示が進み画面面積が大きくなると、斜め方向のある視点から画面を見た場合画面中央と画面端で見え方が異なり正しい表示が不可能になる。

10

【 0 0 0 4 】

この問題に対して、基板に対して平行方向に電界を発生させ、ダイレクタを水平面内で回転させて表示を行うインプレーンスイッチングモード（以下IPSモードと呼ぶ）が開発されている。基板に平行な電界により液晶を駆動させる液晶表示装置は、液晶が水平方向に配向しているので視点を動かしても液晶の複屈折性が大きく変化しないため、TNモードの液晶表示装置に比較して、広視野角を達成することができる。

【 0 0 0 5 】

また、IPSモードと同様に基板に平行な電界により広視野角を得る方法として非特許文献 1 または特許文献 1 には誘電率異方性が正の液晶を基板に対して垂直にホメオトロピック配向させておき、基板に水平方向の電界で液晶分子を基板と水平方向に倒す方式が述べられている。このとき、電界の方向のためホメオトロピック配向させた液晶分子は傾く方向が異なる 2 つ以上の領域に分かれる。ホメオトロピック配向の液晶自体は、特に広い視野角を得られるわけではないが、上記の方向で 2 つ以上の領域に分けることにより、透過光強度の変化を緩やかにして広視野を得ることができる。

20

【 0 0 0 6 】

IPSモードにより動作する液晶表示装置は、例えば特許文献 2（以下「従来例 1」）に開示されているように、画素電極と共通電極線の間に電圧を印加し、基板面にほぼ平行な電界を発生させて液晶を駆動していた。図 1 2 に従来例 1 の平面図、また、図 1 3 に図 1 2 中の A - A' 線の断面図を示す。従来例 1 の液晶表示装置は、薄膜トランジスタの存在する基板 1（以下、TFT基板と呼ぶ）上にマトリクス状に配置された複数の走査線 3、信号線 7 及び共通電極線 1 4 を備え、走査線と信号線の交差部には薄膜トランジスタ及び画素電極 1 1 を有している。画素電極 1 1 と共通電極線 1 4 から延びるCOM電極 1 2 は図 1 2 の平面図に示すようにストライプ状に両電極が平行になるよう設置され、基板面に平行で両電極に直交する成分を主とした電界を発生できる。なお、共通電極をCOM電極と称して表現している。

30

【 0 0 0 7 】

さらに、このTFT基板と液晶層 1 3 とを介して対向して、遮光層 1 5 と、カラーフィルタ 9 R、9 B、9 G、液晶配向層（図示せず）とを有する基板 2（以下、対向基板と呼ぶ）を設置し、一つのアクティブマトリクス液晶表示装置を形成している。ここで、従来例 1 の特徴は、カラーフィルタ及び遮光層が対向基板 2 上に形成されていることにある。

40

【 0 0 0 8 】

また、従来、カラーフィルタがTFT基板側に形成された液晶表示装置が特許文献 3 において提案されている（以下従来例 2 とする）。図 1 4 に従来例 2 の平面図を、図 1 5 に図 1 4 中の A - A' 線の断面図を示す。また、図 1 6（a）～（h）は、その製造工程を示す図である。従来例 2 の液晶表示装置は以下のような構成をしている。

【 0 0 0 9 】

一方の基板 1 上に走査線 3、走査線 3 に電氣的に接続されたゲート電極 3 a 及び共通電極線 1 4 が設置されている。その上層にゲート絶縁膜 4 が形成され、このゲート絶縁膜 4 の上層に能動層となる半導体層 5 が形成されている。その上層にソース電極 7 a、信号線 7 及びドレイン電極 7 b が形成されている。信号線 7 とソース電極 7 a は接続されている。

50

また、ソース電極 7a とドレイン電極 7b は n 型半導体層 6 を介して半導体層 5 と接続されている。それらの上層には薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜 8 が設置され、その上層には遮光層 20、それぞれ赤・緑・青の光を通過させるカラーフィルタ 9 R・9G・9B、チャージアップしにくい透明な絶縁材料からなるオーバーコート層 10 が設置され、その上層には共通電極線 14、共通電極線 14 と接続された COM 電極 12 が設置されている。その上層には絶縁膜 21 を挟んで薄膜トランジスタのソース電極 7b とコンタクトホールを介して接続された金属よりなる櫛歯状の画素電極 11 が設置されている。画素電極 11 と COM 電極 12 は、その間に発生する電界が基板に水平方向の成分が主となるよう配置されている。その上層には図示しないが液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾きを制御するための液晶配向層が設置され薄膜トランジスタ基板（以下 TFT 基板とする）を形成している。

10

【0010】

もう一方の基板 2 上には図示しないが液晶配向層が設置され、対向基板を形成している。TFT 基板と対向基板は液晶配向層同士が向かい合うように設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層 13 が設置される構成となっている。ここで、液晶層中の液晶分子は基板に平行に配向されている。

【0011】

従来例 2 の液晶表示装置は、カラーフィルタ 9 上に配置された画素電極 11 と COM 電極 12 の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子 200 を駆動している。言い換えるならば、カラーフィルタ 9 と液晶層 13 とが、画素電極 11 と COM 電極 12 とを挟んで配置されているようにした。この従来例 2 によれば、液晶分子 200 を動かすための電界が TFT 基板側に回り込みカラーフィルタ 9 に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層 13 とカラーフィルタ 9 の間には画素電極 11 と COM 電極 12 が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極 11 と COM 電極 12 に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、従来例 2 ではカラーフィルタ 9 上にオーバーコート層 10 が形成され、その上に液晶層 13 が形成されているが、オーバーコート層 10 は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よって、さらに液晶層 13 への影響は少なくなる。

20

【0012】

なお、後述するように、本発明に関連すると思われる特許文献 4 および非特許文献 2 もある。

30

【0013】

【特許文献 1】

特開平 10 - 186351 号公報

【特許文献 2】

特開平 6 - 148595 号公報

【特許文献 3】

特願平 11 - 168334 号

【特許文献 4】

特開平 9 - 311347 号公報

40

【非特許文献 1】

Journal of Applied Physics, Vol. 45, No. 12 (1974) P. 5466

【非特許文献 2】

エ - エムエルシ - ディ - '96 / アイディ - ダブリュ'96 のダイジェスト・オブ・テクニカル・ペーパーズ (AM - LCD '96 / IDW '96 Digest of Technical Papers) P. 337

【0014】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来例 1 の様にカラーフィルタが対向基板上に形成される構造の場合、次のよう

50

な問題点があった。カラーフィルタは、通常顔料を分散した有機ポリマーを用いフォトリソグラフィ技術により色層を形成し製造される。よって、カラーフィルタは非常に多くの有機物やイオン性の物質を含んでいる。液晶層中に印加されている交流駆動電圧に僅かでも直流電圧成分が含まれている場合、不純物イオンが偏在化してカラーフィルタ上に電界を形成してしまう。その結果、液晶を駆動する際、駆動電界を妨害して目的の電界を液晶に印加できなくなり正常な表示が不能になる。カラーフィルタの持つ電位は、直流成分のゆらぎあるいは不純物分布の影響でパネル面内でばらつくため表示としてはムラとなって現れる。また、駆動電界を除去した後もカラーフィルタ上の電荷はしばらくの間残るため液晶層 1 3 には弱い電界が作用した状態となって、長期残像やムラの原因となり表示品位を低下させる。従来の技術ではカラーフィルタは画素電極や共通電極線に対して液晶層 1 3 を挟んで対向基板上にあるため画素電極や共通電極線とカラーフィルタの電位差によりカラーフィルタ上の電界は基板に垂直な成分を含んでおり、基板間の複屈折性が大きく変化し長期残像や表示ムラの程度は T N モードに比べ非常に大きい。

10

【 0 0 1 5 】

また、従来例 2 は、従来例 1 の問題点を解決するものであるが、なお次のような欠点がある。すなわち、従来例 2 では画素電極と C O M 電極が絶縁層（層間分離膜）2 1 を介して異なる層に配置されている。よって、層間分離膜の形成および配線形成工程が増え、作製コストが増すばかりか生産歩留まりも低下してしまう。

【 0 0 1 6 】

【課題を解決するための手段】

20

本発明は、面内に水平な電界を用いて液晶を駆動する方式の液晶表示装置の製造方法において、カラーフィルタを T F T 基板上に作成し、更にその上層に共通電極と画素電極を同層の電極により作成するとともに、前記画素電極および前記 C O M 電極は各画素ごとに設けられたそれぞれのコンタクトホールを介して前記ドレイン電極および共通電極線にそれぞれ接続することを特徴とする。

【 0 0 1 8 】

また、本発明によれば、一方の基板上に、走査線、ゲート電極および共通電極線を形成する工程と、これらの配線および電極を含む上記の一方の基板上の全面にゲート絶縁膜を形成する工程と、ゲート電極の上部のゲート絶縁膜上に半導体層を形成した後、半導体層上にソース電極およびドレイン電極を形成して薄膜トランジスタを形成する工程と、ゲート絶縁膜上に信号線を形成する工程と、薄膜トランジスタ、信号線を含む上記の一方の基板上の全面にパッシベーション膜を設ける工程と、薄膜トランジスタの上部のパッシベーション膜上に遮光膜を、その他の部分のパッシベーション膜上にカラーフィルタを形成する工程と、カラーフィルタ上層に画素電極と共通信号が印加される C O M 電極とを形成するとともに、画素電極および C O M 電極は各画素ごとに設けられたそれぞれのコンタクトホールを介してドレイン電極および共通電極線にそれぞれ接続する工程と、上記の一方の基板ともう一方の基板とを対向させその間に液晶を封止する工程とを有する液晶表示装置の製造方法が得られる。なお、カラーフィルタ上にオーバーコート層を形成してもよい。

30

【 0 0 1 9 】

【発明の実施の形態】

40

次に本発明について図面を参照して説明する。図 1 は本発明の第 1 の実施の形態の構成を示す平面図、図 2 は図 1 の A - A ' 線の断面図、図 3 は図 1 の B - B ' 線の断面図を示す。

【 0 0 2 0 】

一方の基板 1 上に走査線 3、走査線 3 に電氣的に接続されたゲート電極 3 a 及び共通電極線 1 4 が設置されている。その上層にゲート絶縁膜 4 が形成され、このゲート絶縁膜の上層に能動層となる半導体層 5 が形成されている。その上層にソース電極 7 a、信号線 7、ドレイン電極 7 b 及び導通部 2 5 が形成されている。信号線 7 とソース電極 7 a は接続されている。また、ソース電極 7 a とドレイン電極 7 b は n 型半導体層 6 を介して半導体層 5 と接続されている。それらの上層には薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜

50

8が設置され、その上層には遮光層20、それぞれ赤・緑・青の光を通過させるカラーフィルタ9R・9G・9B、チャージアップしにくい透明な絶縁材料からなるオーバーコート層10が設置され、その上層には薄膜トランジスタのソース電極7bとコンタクトホールを介して接続された金属よりなる画素電極11、共通電極線14と導通部25及びコンタクトホールを介して接続されたCOM電極12が設置されている。画素電極11とCOM電極12は、その間に発生する電界が基板に水平方向の成分が主となるよう配置されている。その上層には図示しないが液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾きを制御するための液晶配向層が設置され薄膜トランジスタ基板（以下TFT基板とする）を形成している。

【0021】

もう一方の基板2上には図示しないが液晶配向層が設置され、対向基板を形成している。TFT基板と対向基板は液晶配向層同士が向かい合うように設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層13が設置される構成となっている。ここで、液晶層中の液晶分子は基板に平行に配向されている。この実施の形態ではポリイミドからなる液晶配向層をラビングすることによって分子配向を行った。ラビング法に限らず、光配向法や酸化シリコンの斜方蒸着法を用いても良い。液晶分子の誘電率異方性は正とした。

【0022】

液晶層中の液晶分子200は図4(a)、(b)に示すように、画素電極11とCOM電極12間に電界が発生していないときは、液晶層13における液晶分子はそれら電極の延在方向にほぼ平行な状態となるよう液晶配向層によりホモジニアス配向している。すなわち、液晶分子の長軸（光学軸）の方向と、画素電極11とCOM電極12との間に形成される電界方向とのなす角度が、例えば、45°以上90°未満となるように、液晶分子は配向されている。

【0023】

ここで、ゲート電極3aに電圧を印加して薄膜トランジスタ（TFT）をオンにすると、ドレイン電極7bに電圧が印加されて、画素電極11とこれに対向配置しているCOM電極12の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子200は、画素電極11とこれに対向配置しているCOM電極12の間に形成される電界の方向に、ほぼ平行な状態となる（図4）。そして、基板1および基板2の外側に設置された偏光板の偏光透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。例えば、一方の偏光板の透過軸を液晶分子200の配向方向とし、もう一方の偏光板の透過軸を90度回転させた方向とすることで、電界が印加されていないとき黒表示となり、印加時には光が透過するノーマリブラック表示となる。

【0024】

次に第1の実施の形態の製造方法について述べる。図7(a)、(a')～(h)、(h')に製造工程を説明する為の断面図を示す。図7(a)、(a')に示すように、一方の基板1に、スパッタによりクロムを成膜しフォトリソグラフィ技術を用いてパターンニングを行うことにより、走査線3、ゲート電極3a及び共通電極線14を形成する。配線材料としてクロムを用いたが、クロムに限らず、モリブデン、チタン、アルミニウム、アルミニウム合金などの抵抗が低く、薄膜形成及びフォトリソグラフィ技術によるパターンニングがしやすい材料ならばよい。また、アルミニウム上にチタンなどのバリアメタルを形成した積層構造の配線としても良い。その後、図7(b)、(b')に示すように、ケミカルベーパーデポジション（以下CVDとする）によりゲート絶縁膜4となる窒化シリコンを全面に成膜する。ゲート絶縁膜上にドーピングされていないアモルファスシリコン（以下a-Siとする）とn+型にドーピングされたアモルファスシリコン（以下n+型a-Siとする）をCVDにより成膜しパターンニングして半導体層5とn+型a-Si6を形成する。半導体層は薄膜トランジスタの能動層となるものであり、n+型a-Si6はドレイン電極7bおよびソース電極7aとa-Siとのオーミックコンタクトを確保するためのものである。

【0025】

10

20

30

40

50

この後、図7(c)、(c')のように、走査線3や共通電極線14の形成された金属層とこの後形成する信号線、ソース電極、ドレイン電極の形成される金属層との導通をとるためのコンタクトホールをゲート絶縁膜をパターンニングすることで形成する。このコンタクトホールの形成は、後のパッシベーション膜のパターンニングと同時に行ってもよい、その際には導通部25は必要がなくなる。この後、図7(d)、(d')のように、半導体層5およびn+型a-Si6上に、クロムをスパッタにより成膜しパターンニングしてドレイン電極7b、ソース電極7aと導通パッドを形成する。その後、n+型a-Siがエッチングされるガス系にてドライエッチングを行い、ドレイン電極7bとソース電極7aの間のn+型a-Siを除去する。これは、ソース電極とドレイン電極間をn+型a-Siを介して直接電流が流れるのを防止するためである。この後、図7(e)、(e')のよう

10

【0026】

このようにして作製した薄膜トランジスタの上層に、図7(f)、(f')に示すように、カラーフィルタ9R、9G、9Bと遮光層20を形成する。例えばアクリル系の感光性ポリマー中に赤・緑・青・黒などの所望の色の顔料を分散したレジストをフォトリソグラフィ技術によりパターンニングし形成する。このときコンタクトホールも形成する。黒レジストは絶縁性の高いものを使用する。黒レジストの絶縁性が低いと薄膜トランジスタ上の遮光層が何らかの電位をもつこととなり、トランジスタのバックチャネルを活性化させ良好な表示ができなくなる。また、特許文献4のようにカラーフィルタの上層に金属からなる遮光層を形成しても良い。次に、図7(g)、(g')のように、感光性で透明性の高いアクリル系ポリマーをフォトリソグラフィ技術によりパターンニングしオーバーコート層10を形成する。オーバーコート層10は、カラーフィルタ9から溶出するイオン等の不純物が液晶層へ混入するのを防止し、また、TFT基板上を平坦化するため液晶層の厚さを面内均一よく制御可能にすると共にディスクリネーションの発生を抑え、良好な表示を得ることに寄与する。オーバーコート層10の材料として感光性のポリマーを用いたが熱硬化性のポリマーを高温で焼成して成膜した後、フォトリソグラフィ技術によりパターンニングしても良い。また、アクリル系のポリマーに限らず、ポリシラザンなど透明でスピ

20

30

【0027】

TFT基板と対向基板2にそれぞれポリイミドよりなる液晶配向層を形成後、両基板をラビング処理し、ギャップに応じた径を有するポリマービーズを全面に散布し、液晶配向層どうしが向かい合うように重ね、接着し、基板間にネマティック液晶を注入する。2枚の偏光板で両基板を挟み、張り付けた。

40

【0028】

以上述べたように、この第1の実施の形態では、カラーフィルタ9上に配置された画素電極11とCOM電極12の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子200を駆動するようにした。言い換えるならば、カラーフィルタ9と液晶層13とが、画素電極11とCOM電極12とを挟んで配置されているようにした。この実施の形態によれば、液晶分子200を動かすための電界がTFT基板側に回り込みカラーフィルタ9に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層13とカラーフィルタ9の間には画素電極11とCOM電極12が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り

50

出す電界は導電体である画素電極 1 1 と C O M (共通) 電極 1 2 に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、第 1 の実施の形態ではカラーフィルタ 9 上にオーバーコート層 1 0 が形成され、その上に液晶層 1 3 が形成されているが、オーバーコート層 1 0 は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よって、さらに液晶層 1 3 への影響は少なくなる。さらに、第 1 の実施の形態では画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。

【 0 0 2 9 】

次に本発明の第 2 の実施の形態について説明する。第 1 の実施の形態と異なる点は画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 を形成する材料が透明導電材料となることのみである。図 1、図 2 および図 3 を参照して説明する。

10

【 0 0 3 0 】

一方の基板 1 上に走査線 3、走査線 3 に電氣的に接続されたゲート電極 3 a 及び共通電極線 1 4 が設置されている。その上層にゲート絶縁膜 4 が形成され、このゲート絶縁膜の上層に能動層となる半導体層 5 が形成されている。その上層にソース電極 7 a、信号線 7、ドレイン電極 7 b 及び導通部 2 5 が形成されている。信号線 7 とソース電極 7 a は接続されている。また、ソース電極 7 a とドレイン電極 7 b は n 型半導体層 6 を介して半導体層 5 と接続されている。それらの上層には薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜 8 が設置され、その上層には遮光層 2 0、それぞれ赤・緑・青の光を通過させるカラーフィルタ 9 R・9 G・9 B、チャージアップしにくい透明な絶縁材料からなるオーバーコート層 1 0 が設置され、その上層には薄膜トランジスタのソース電極 7 b とコンタクトホールを介して接続された透明な画素電極 1 1、共通電極線 1 4 と導通部 2 5 及びコンタクトホールを介して接続された透明な C O M 電極 1 2 が設置されている。画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 は、その間に発生する電界が基板に水平方向の成分が主となるよう配置されている。その上層には図示しないが液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾きを制御するための液晶配向層が設置され薄膜トランジスタ基板 (以下 T F T 基板とする) を形成している。

20

【 0 0 3 1 】

もう一方の基板 2 上には液晶配向層が設置され、対向基板を形成している。T F T 基板と対向基板は液晶配向層同士が向かい合うように設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層 1 3 が設置される構成となっている。ここで、液晶層中の液晶分子は基板に平行に配向されている。

30

【 0 0 3 2 】

ここで、ゲート電極 3 a に電圧を印加して薄膜トランジスタ (T F T) をオンにすると、ドレイン電極 7 b に電圧が印加されて、画素電極 1 1 とこれに対向配置している C O M 電極 1 2 の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子 2 0 0 は、画素電極 1 1 とこれに対向配置している C O M 電極 1 2 の間に形成される電界の方向に、ほぼ平行な状態となる。そして、基板 1 および基板 2 の外側に設置された偏光板の変更透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。さらに、この構成では、画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 が透明な電極であるため、画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 の領域も光が透過する。画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 の直上の領域は基板に対して平行な電界が弱い、十分に平行電界が印加されている領域の液晶分子の影響で画素電極 1 1 と C O M 電極 1 2 の直上の領域の液晶分子も動き光の透過率変化に寄与する。よって、金属電極を用いた場合に比べ明るい表示となる。

40

【 0 0 3 3 】

次に第 2 実施の形態の製造方法について述べる。基板 1 にオーバーコート層 1 0 を形成するまでは第 1 の実施の形態とまったく同様である。オーバーコート層 1 0 の上層に透明な導電材料である I T O (I n d i u m - T i m - O x i d e) をスパッタにより成膜しパターンニングすることにより画素電極 1 1 及び C O M 電極 1 2 を形成する。このようにして T F T 基板を得た。T F T 基板と対向基板 2 にそれぞれポリイミドよりなる液晶配向層

50

を形成後、両基板をラビング処理し、ギャップに応じた径を有するポリマービーズを全面に散布し、液晶配向層どうしが向かい合うように重ね、接着し、基板間にネマティック液晶を注入する。2枚の偏光板で両基板を挟み、張り付けた。

【0034】

次に第2の実施の形態の動作について説明する。第1の実施の形態と同様に第2の実施の形態では、カラーフィルタ9上に配置された画素電極11とCOM電極12の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子200を駆動するようにした。言い換えるならば、カラーフィルタ9と液晶層13とが、画素電極11とCOM電極12とを挟んで配置されているようにした。この実施の形態によれば、液晶分子200を動かすための電界がTFT基板側に回り込みカラーフィルタ9に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層13とカラーフィルタ9の間には画素電極11とCOM電極12が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極11と共通電極12に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、カラーフィルタ9上にオーバーコート層10が形成され、その上に液晶層13が形成されているが、オーバーコート層10は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よってさらに液晶層13への影響は少なくなる。

10

【0035】

第1の実施の形態と同様に第2の実施の形態では画素電極11とCOM電極12が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。また、第2の実施の形態では画素電極11とCOM電極12が透明な導電材料で形成されているため画素電極11とCOM電極12の直上の領域が透過率の変化領域として使用できるため明るい表示が可能である。

20

【0036】

図17に主に基板に垂直な電界により液晶を駆動する液晶表示装置の構成を示す平面図を示す。図18に図17中のA-A'線の断面図を示す。図17、図18に示されるようにTFT基板において第1の実施の形態との相違点は共通電極線およびCOM電極がTFT基板上に形成されていないことのみである。第1の実施の形態で示したように共通電極線は、ゲート電極と同時に、COM電極は画素電極と同時に、フォトリソグラフィ技術によりパターンニングされるものであるため、フォトリソグラフィ用のマスクを変更するだけで取り除くことができる。しかるに、第2の実施の形態では作製工程は全く同一である。

30

【0037】

層構造が異なる等で作製工程が異なる液晶表示装置を同一の製造ラインで作製する場合、成膜やエッチング等を行う際の最適な条件も変わるため、製造装置の設定を変更しなくてはならない。設定の変更には時間がかかるため、生産の効率が非常に悪くなる。また、液晶表示装置の製造装置は非常に高価であり、設定切り替えをなくすため装置を増設することは製造コストの増加につながる。

【0038】

本発明は基板に垂直な電界により液晶を駆動する液晶表示装置とTFT基板の作製工程が同一であるため、製造装置の設定変更なく透過型と同一の製造ラインで同時に作製できる。よって、本発明を用いることにより、低コストの液晶表示装置を作製できる。

40

【0039】

次に本発明の第3の実施の形態について説明する。図8に第3の実施の形態の構成を示す平面図を、図9に図8のA-A'線の断面図を示す。一方の基板1上に走査線3、走査線3に電気的に接続されたゲート電極3a及び共通電極線14が設置されている。その上層にゲート絶縁膜4が形成され、このゲート絶縁膜の上層に能動層となる半導体層5が形成されている。その上層にソース電極7a、信号線7、ドレイン電極7b及び導通部25が形成されている。信号線7とソース電極7aは接続されている。また、ソース電極7aとドレイン電極7bはn型半導体層6を介して半導体層5と接続されている。それらの上層には薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜8が設置され、その上層にはそれぞれ赤・緑・青の光を通過させるカラーフィルタ9R・9G・9B、チャージアップしにく

50

い透明な絶縁材料からなるオーバーコート層 10 が設置され、その上層には薄膜トランジスタのドレイン電極 7b とコンタクトホールを介して接続された金属よりなる櫛歯状の画素電極 11、共通電極線 14 と接続された COM 電極 12 が設置されている。画素電極 11 と COM 電極 12 は、その間に発生する電界が基板に水平方向の成分が主となるよう配置されている。また、少なくとも画素電極 11 と COM 電極 12 のどちらかは、表示と関係のない部分および TFT 部の遮光層を兼ねている。その上層には図示しないが液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾きを制御するための液晶配向層が設置され薄膜トランジスタ基板（以下 TFT 基板とする）を形成している。

【0040】

もう一方の基板 2 上には図示しないが液晶配向層が設置され、対向基板を形成している。TFT 基板と対向基板は液晶配向層同士が向かい合うように設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層 13 が設置される構成となっている。ここで、液晶層中の液晶分子は基板に平行に配向されている。液晶分子の誘電率異方性は正とした。液晶分子を動かして表示を行う過程は第 1 の実施の形態と同様である。

10

【0041】

次に第 3 の実施の形態の製造方法について述べる。基板 1 にパッシベーション膜 8 を形成するまでは第 1 の実施の形態とまったく同様である。その後、第 1 の実施の形態と同様の手法でカラーフィルタ 9R、9G、9B を形成する。次に、第 1 の実施の形態と同様の手法でオーバーコート層 10 を形成する。オーバーコート層 10 の上層にクロムをスパッタにより成膜しパターンニングすることにより画素電極 11 及び COM 電極 12 を形成する。アルミニウム等の他の金属を用いてもよい。

20

【0042】

このとき、少なくとも画素電極 11 と COM 電極のどちらかにて TFT の遮光を行うが、TFT のバックチャネルが活性化し良好な表示ができなくなるのを防ぐため、TFT の直上にカラーフィルタとオーバーコートが十分な厚みを持って形成され、また、カラーフィルタとオーバーコート層の誘電率が低いことが望ましい。このようにして TFT 基板を得た。TFT 基板と対向基板 2 にそれぞれポリイミドよりなる液晶配向層を形成後、両基板をラビング処理し、ギャップに応じた径を有するポリマービーズを全面に散布し、液晶配向層どうしが向かい合うように重ね、接着し、基板間にネマティック液晶を注入する。2 枚の偏光板で両基板を挟み、張り付けた。

30

【0043】

次に第 3 の実施の形態の動作について説明する。カラーフィルタ 9 上に配置された画素電極 11 と COM 電極 12 の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子 200 を駆動するようにした。言い換えるならば、カラーフィルタ 9 と液晶層 13 とが、画素電極 11 と COM 電極 12 とを挟んで配置されているようにした。この実施の形態によれば、液晶分子 200 を動かすための電界が TFT 基板側に回り込みカラーフィルタ 9 に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層 13 とカラーフィルタ 9 の間には画素電極 11 と COM 電極 12 が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極 11 と共通電極 12 に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、カラーフィルタ 9 上にオーバーコート層 10 が形成され、その上に液晶層 13 が形成されているが、オーバーコート層 10 は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よってさらに液晶層 13 への影響は少なくなる。

40

【0044】

第 3 の実施の形態では画素電極 11 と COM 電極 12 が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。また、画素電極 11 または COM 電極 12 が遮光層を兼ねるため、独立に遮光層を形成する必要がなく工程が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。

【0045】

50

次に本発明の参考例について説明する。図10に参考例の構成を示す平面図を、図11に図10のB-B'線の断面図を示す。一方の基板1上に走査線3及び走査線3に電氣的に接続されたゲート電極3aが設置されている。その上層にゲート絶縁膜4が形成され、このゲート絶縁膜の上層に能動層となる半導体層5が形成されている。その上層にソース電極7a、信号線7、ドレイン電極7b及び導通部25が形成されている。信号線7とソース電極7aは接続されている。また、ソース電極7aとドレイン電極7bはn型半導体層6を介して半導体層5と接続されている。それらの上層には薄膜トランジスタを保護するパッシベーション膜8が設置され、その上層にはそれぞれ赤・緑・青の光を通過させるカラーフィルタ9R・9G・9B、チャージアップしにくい透明な絶縁材料からなるオーバーコート層10が設置され、その上層には薄膜トランジスタのドレイン電極7bとコンタクトホールを介して接続された金属よりなる櫛歯状の画素電極11、共通電極線14、および共通電極線14と接続されたCOM電極12が設置されている。画素電極11とCOM電極12は、その間に発生する電界が基板に水平方向な成分が主となるよう配置されている。第3の実施の形態と同様に画素電極11、共通電極線14、COM電極12を遮光層として用いてもよい。また、第2の実施の形態と同様に画素電極11、共通電極線14及びCOM電極12を透明な材料で形成してもよい。その上層には図示しないが液晶分子を液晶の動作モードに適した配列や傾きを制御するための液晶配向層が設置され薄膜トランジスタ基板(以下TFT基板とする)を形成している。

10

【0046】

もう一方の基板2上には図示しないが液晶配向層が設置され、対向基板を形成している。TFT基板と対向基板は液晶配向層同士が向かい合うように設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層13が設置される構成となっている。ここで、液晶層中の液晶分子は基板に平行に配向されている。液晶分子を動かして表示を行う過程は第1の実施の形態と同様である。また、この参考例の製造方法は、第1の実施の形態または第2の実施の形態と同様である。

20

【0047】

第1の実施の形態と同様に参考例では、カラーフィルタ9上に配置された画素電極11とCOM電極12の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子200を駆動するようにした。言い換えるならば、カラーフィルタ9と液晶層13とが、画素電極11とCOM電極12とを挟んで配置されているようにした。この参考例によれば、液晶分子200を動かすための電界がTFT基板側に回り込みカラーフィルタ9に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層13とカラーフィルタ9の間には画素電極11とCOM電極12が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極11と共通電極12に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、カラーフィルタ9上にオーバーコート層10が形成され、その上に液晶層13が形成されているが、オーバーコート層10は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よってさらに液晶層13への影響は少なくなる。この参考例では画素電極11とCOM電極12が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。

30

【0048】

なお、フォトリソグラフィによるパターンニングを行う工程中にごみ等の影響で目的以外のパターンを形成してしまうことがある。目的以外のパターンは本来は接続してはならないパターン同士を短絡させ回路を狂わせることがある。特に走査線、信号線、共通電極線等に意図しない短絡が発生するとその線に接続されたすべての画素において表示不良が発生することとなり表示品位を著しく悪化させ不良品となる。参考例では共通電極線と走査線が絶縁体を挟んで別の層に形成されているため共通電極線と走査線の短絡が少なくなり、その結果不良品は減少し、生産歩留まりが上昇する。

40

【0049】

次に本発明の第4の実施の形態について説明する。第4の実施の形態は第1の実施の形態と同様の手法で形成されたTFT基板と対向基板の液晶配向層同士が向かい合うように

50

設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層 13 が設置される構成となっている。ここで、液晶層中の液晶分子は基板に平行に配向されている。また、液晶分子の誘電率異方性は負とした。液晶層中の液晶分子 200 は図 5 (a)、(b) に示すように、画素電極 11 と COM 電極 12 間に電界が発生していないときは、それら電極の延在方向にほぼ平行な状態となるよう液晶配向層によりホモジニアス配向している。

【0050】

ここで、ゲート電極 3a に電圧を印加して薄膜トランジスタ (TFT) をオンにすると、ドレイン電極 7b に電圧が印加されて、画素電極 11 とこれに対向配置している COM 電極 12 の間に電界が誘起される。そして、この電界により、液晶分子 200 は、画素電極 11 とこれに対向配置している COM 電極 12 の間に形成される電界の方向に、ほぼ垂直な状態となる。そして、基板 1 および基板 2 の外側に設置された偏光板の偏光透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。例えば、一方の偏光板の透過軸を液晶分子 200 の配向方向とし、もう一方の偏光板の透過軸を 90 度回転させた方向とすることで、電界が印加されていないとき黒表示となり、印加時には光が透過するノーマリブラック表示となる。なお、TFT 基板は第 1 の実施の形態と同様のものを用いたが、第 2、第 3、参考例の TFT 基板を用いてもよい。

10

【0051】

この実施の形態では、第 1 の実施の形態と同様に、カラーフィルタ 9 上に配置された画素電極 11 と COM 電極 12 の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子 200 を駆動するようにした。言い換えるならば、カラーフィルタ 9 と液晶層 13 とが、画素電極 11 と COM 電極 12 とを挟んで配置されているようにした。この参考例によれば、液晶分子 200 を動かすための電界が TFT 基板側に回り込みカラーフィルタ 9 に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層 13 とカラーフィルタ 9 の間には画素電極 11 と COM 電極 12 が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極 11 と共通電極 12 に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、ではカラーフィルタ 9 上にオーバーコート層 10 が形成され、その上に液晶層 13 が形成されているが、オーバーコート層 10 は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よってさらに液晶層 13 への影響は少なくなる。

20

30

【0052】

この実施の形態では、画素電極 11 と COM 電極 12 が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。なお、基板に平行方向に配向させた誘電率異方性が負の液晶層を用いると、カラーフィルタの作る電界がわずかに液晶層中にもれたとしても、液晶分子が基板に対して垂直方向に立ち上がることはなく、よって液晶層の複屈折性を大きく変化させることはなく、表示ムラの程度を小さくできる。

【0053】

次に本発明の第 5 の実施の形態について説明する。第 5 の実施の形態は第 1 の実施の形態と同様の手法で形成された TFT 基板と対向基板の液晶配向層同士が向かい合うように設置され、向かい合う液晶配向層の間には液晶層 13 が設置される構成となっている。両基板の液晶配向層には垂直配向膜が用いられている。この液晶配向膜表面は、必要に応じラビング、または、光配向処理が施される。液晶層 13 中の液晶の誘電率異方性は正とする。

40

【0054】

以上のように構成された液晶表示装置では、図 6 (a)、(b) に示すように、液晶層 13 に電界がかかっていないときには、液晶層 13 における液晶分子 200 は、基板にほぼ垂直に配向している。液晶の誘電率異方性は正とする。ここで、ゲート電極 3a に電圧を印加して TFT をオンにすると、ソース電極 7a に電圧が印加されて、画素電極 11 とこれに対向配置している COM 電極 12 の間に電界が誘起される。そしてこの電界により、

50

液晶分子 200 は画素電極 11 とこれに対向配置している共通電極 12 の間に形成される電界の方向に、ほぼ平行な状態、すなわち、基板方向に倒れていくことになる。また、このとき電界の方向が完全に基板と平行でないため、電極間の液晶分子は 2 方向に分かれて倒れる。

【0055】

このように本実施の形態の方法では、特別に配向膜に処理を加えることをしなくても、自動的に液晶の倒れる方向を分割することができ、広視野角化が達成できるが、基板にあらかじめラビング、または光配向などの方法を使用して、分割形状に従ったプレチルト角の制御を行い、初期配向の制御を極めて確実にし、駆動電圧により、このような配向が乱れることを防止するために、さらに液晶中に少量混合した重合性のモノマーまたはオリゴマーを高分子化するとより優れた効果が得られる。この際、ラビングの場合はフォトレジストを用いた分割配向を行う。また、光配向の場合は、例えば、ケイ皮酸基のような偏光により液晶の配向を制御できる官能基を有する物質、または、非特許文献 2 に記載されているような偏光照射により官能基が重合するような高分子を配向膜に用いて、分割形状にそった方向にプレチルト角がつくように、各部にマスクを介して、斜め方向から偏光を照射する。このような分割配向の方法はよく知られているが、液晶中に少量混合した重合性のモノマーまたはオリゴマーを高分子化することにより、駆動時においてもより確実に分割を維持することができる。本発明に使用するモノマー、オリゴマーとしては、光硬化性モノマー、熱硬化性モノマー、あるいはこれらのオリゴマー等のいずれを使用することもでき、また、これらを含むものであれば他の成分を含んでいてもよい。

【0056】

本実施の形態に使用する「光硬化性モノマー又はオリゴマー」とは、可視光線により反応するものだけでなく、紫外線により反応する紫外線硬化モノマー等を含み、操作の容易性からは特に後者が望ましい。また、本実施の形態で使用する高分子化合物は、液晶性を示すモノマー、オリゴマーを含む液晶分子と類似の構造を有するものでもよいが、必ずしも液晶を配向させる目的で使用されるものではないため、アルキレン鎖を有するような柔軟性のあるものであってもよい。また、単官能性のものであってもよいし、2 官能性のもの、3 官能以上の多官能性を有するモノマー等でもよい。

【0057】

本実施の形態で使用する光または紫外線硬化モノマーとしては、例えば、2 - エチルヘキシルアクリレート、ブチルエチルアクリレート、ブトキシエチルアクリレート、2 - シアノエチルアクリレート、ベンジルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、2 - ヒドロキシプロピルアクリレート、2 - エトキシエチルアクリレート、N、N - エチルアミノエチルアクリレート、N、N - ジメチルアミノエチルアクリレート、ジシクロペンタニルアクリレート、ジシクロペンテニルアクリレート、グリシジルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボニルアクリレート、イソデシルアクリレート、ラウリルアクリレート、モルホリンアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、フェノキシジエチレングリコールアクリレート、2, 2, 2 - トリフルオロエチルアクリレート、2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピルアクリレート、2, 2, 3, 3 - テトラフルオロプロピルアクリレート、2, 2, 3, 4, 4, 4 - ヘキサフルオロブチルアクリレート等の単官能アクリレート化合物を使用することができる。また、2 - エチルヘキシルメタクリレート、ブチルエチルメタクリレート、ブトキシエチルメタクリレート、2 - シアノエチルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2 - ヒドロキシプロピルメタクリレート、2 - エトキシエチルアクリレート、N、N - ジエチルアミノエチルメタクリレート、N、N - ジメチルアミノエチルメタクリレート、ジシクロペンタニルメタクリレート、ジシクロペンテニルメタクリレート、グリシジルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレート、イソボニルメタクリレート、イソデシルメタクリレート、ラウリルメタクリレート、モルホリンメタクリレート、フェノキシエチルメタクリレート、フェノキシジエチレングリコールメタクリレート、2, 2, 2 - トリフルオロエチルメタクリレート、2, 2, 3, 3 - テトラフルオロプロピルメタクリレ

ート, 2, 2, 3, 4, 4, 4 - ヘキサフルオロブチルメタクリレート等の単官能メタクリレート化合物を使用することができる。さらに、4, 4' - ビフェニルジアクリレート, ジエチルスチルベストロールジアクリレート, 1, 4 - ビスアクリロイルオキシベンゼン, 4, 4' - ビスアクリロイルオキシジフェニルエーテル, 4, 4' - ビスアクリロイルオキシジフェニルメタン, 3, 9 - ビス[1, 1 - ジメチル - 2 - アクリロイルオキシエチル] - 2, 4, 8, 10 - テトラスピロ[5, 5]ウンデカン, α , α' - ビス[4 - アクリロイルオキシフェニル] - 1, 4 - ジイソプロピルベンゼン, 1, 4 - ビスアクリロイルオキシテトラフルオロベンゼン, 4, 4' - ビスアクリロイルオキシオクタフルオロビフェニル, ジエチレングリコールジアクリレート, 1, 4 - ブタンジオールジアクリレート, 1, 3 - ブチレングリコールジアクリレート, ジシクロペンタニルジアクリレート, グリセロールジアクリレート, 1, 6 - ヘキサンジオールジアクリレート, ネオペンチルグリコールジアクリレート, テトラエチレングリコールジアクリレート, トリメチロールプロパントリアクリレート, ペンタエリスリトールテトラアクリレート, ペンタエリスリトールトリアクリレート, ジトリメチロールプロパンテトラアクリレート, ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート, ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアクリレート, 4, 4' - ジアクリロイルオキシスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジメチルスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジエチルスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジプロピルスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジブチルスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジベンチルスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジヘキシルスチルベン, 4, 4' - ジアクリロイルオキシジフルオロスチルベン, 2, 2, 3, 3, 4, 4 - ヘキサフルオロペンタンジオール - 1, 5 - ジアクリレート, 1, 1, 2, 2, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル - 1, 3 - ジアクリレート, ウレタンアクリレートオリゴマ等の多官能アクリレート化合物を用いることができる。さらにまた、ジエチレングリコールジメタクリレート, 1, 4 - ブタンジオールジメタクリレート, 1, 3 - ブチレングリコールジメタクリレート, ジシクロペンタニルジメタクリレート, グリセロールジメタクリレート, 1, 6 - ヘキサンジオールジメタクリレート, ネオペンチルグリコールジメタクリレート, テトラエチレングリコールジメタクリレート, トリメチロールプロパントリメタクリレート, ペンタエリスリトールテトラメタクリレート, ペンタエリスリトールトリメタクリレート, ジトリメチロールプロパンテトラメタクリレート, ジペンタエリスリトールヘキサメタクリレート, ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタメタクリレート, 2, 2, 3, 3, 4, 4 - ヘキサフルオロペンタンジオール - 1, 5 - ジメタクリレート, ウレタンメタクリレートオリゴマ等の多官能メタクリレート化合物, その他スチレン, アミノスチレン, 酢酸ビニル等があるが、これに限定されるものではない。

【0058】

また、本実施の形態の素子の駆動電圧は、高分子材料と液晶材料の界面相互作用にも影響されるため、フッ素元素を含む高分子化合物であってもよい。このような高分子化合物として、2, 2, 3, 3, 4, 4 - ヘキサフルオロペンタンジオール - 1, 5 - ジアクリレート, 1, 1, 2, 2, 3, 3 - ヘキサフルオロプロピル - 1, 3 - ジアクリレート, 2, 2, 2 - トリフルオロエチルアクリレート, 2, 2, 3, 3, 3 - ペンタフルオロプロピルアクリレート, 2, 2, 3, 3 - テトラフルオロプロピルアクリレート, 2, 2, 3, 4, 4, 4 - ヘキサフルオロブチルアクリレート, 2, 2, 2 - トリフルオロエチルメタクリレート, 2, 2, 3, 3 - テトラフルオロプロピルメタクリレート, 2, 2, 3, 4, 4, 4 - ヘキサフルオロブチルメタクリレート, ウレタンアクリレートオリゴマ等を含む化合物から合成された高分子化合物が挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0059】

本実施の形態に使用する高分子化合物として光または紫外線硬化モノマーを使用する場合には、光または紫外線用の開始剤を使用することもできる。この開始剤としては、種々のものが使用可能であり、たとえば、2, 2 - ジエトキシアセトフェノン, 2 - ヒドロキシ

10

20

30

40

50

- 2 - メチル - 1 - フェニル - 1 - オン, 1 - (4 - イソプロピルフェニル) - 2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロパン - 1 - オン, 1 - (4 - ドデシルフェニル) - 2 - ヒドロキシ - 2 - メチルプロパン - 1 - オン等のアセトフェノン系、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルジメチルケタール等のベンゾイン系、ベンゾフェノン、ベンゾイル安息香酸、4 - フェニルベンゾフェノン、3, 3 - ジメチル - 4 - メトキシベンゾフェノン等のベンゾフェノン系、チオキサソソ, 2 - クロルチオキサソソ, 2 - メチルチオキサソソ等のチオキサソソ系、ジアゾニウム塩系、スルホニウム塩系、ヨードニウム塩系、セレンニウム塩系等が使用できる。

【 0 0 6 0 】

両基板の外側に偏光板の偏光透過軸を所定角度に配置しておくことで、上述した液晶分子の動きによって光の透過率を変化させることができる。また、偏光透過軸を直交させた場合は、ノーマリブラックモードとなるが、初期の液晶配向のリタデーションの観察角度依存をなくすため負の一軸の補償フィルムおよび正の一軸の補償フィルムを組み合わせることができる。これにより、黒状態の観察角度依存性がなくなり、画質が向上するとともに、広視野角化が図れる。なお、TFT基板は第1の実施の形態と同様のものを用いたが、第2、第3の実施の形態、参考例のTFT基板を用いてもよい。

【 0 0 6 1 】

この第5の実施の形態では、第1の実施の形態と同様に、カラーフィルタ9上に配置された画素電極11とCOM電極12の間に電界を形成することで、それらの上に配置された液晶分子200を駆動するようにした。言い換えるならば、カラーフィルタ9と液晶層13とが、画素電極11とCOM電極12とを挟んで配置されているようにした。この実施の形態によれば、液晶分子200を動かすための電界がTFT基板側に回り込みカラーフィルタ9に印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層13とカラーフィルタ9の間には画素電極11とCOM電極12が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極11とCOM(共通)電極12に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、カラーフィルタ9上にオーバーコート層10が形成され、その上に液晶層13が形成されているが、オーバーコート層10は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よってさらに液晶層13への影響は少なくなる。

【 0 0 6 2 】

また、この実施の形態では、第1の実施の形態と同様に、画素電極11とCOM電極12が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。さらに、この実施の形態では、液晶分子が基板に対しほぼ垂直に配向した状態から、電界により倒れる構成のため、従来のような液晶分子が単に基板に平行な面内で回転する構成に比べ、斜め方向から観察したときの色付きもなく、広い視野角特性を与える。

【 0 0 6 3 】

【 発明の効果 】

以上述べたように、本発明では、カラーフィルタと液晶層とが、画素電極とCOM電極とを挟んで配置されているようにしたので、液晶分子を動かすための電界がTFT基板側に回り込みカラーフィルタに印加され不純物イオンが偏在化したとしても、液晶層とカラーフィルタの間には画素電極とCOM電極が存在するため、カラーフィルタの不純物イオンが作り出す電界は導電体である画素電極とCOM(共通)電極に収束し、液晶層には大きな影響を与えない。また、カラーフィルタ上にオーバーコート層が形成され、その上に液晶層が形成されているが、オーバーコート層は顔料等が含まれていないため不純物イオンが少なく殆どチャージアップしない。よって、さらに液晶層への影響は少なくなる。さらに、本発明では、画素電極とCOM電極が同一の層で形成されているため、別の層で形成するよりも工程数が少なくすみ、作製コストを少なくできる上、作製時間も短縮できる。

【 図面の簡単な説明 】

【 図 1 】 本発明の第1の実施の形態の構成を示す平面図である。

【図 2】図 1 の A - A' 線の断面図である。

【図 3】図 1 の B - B' 線の断面図である。

【図 4】(a)、(b) は本発明の液晶表示装置における液晶層内を説明する模式図である。

【図 5】(a)、(b) は本発明の液晶表示装置における液晶層内を説明する模式図である。

【図 6】(a)、(b) は本発明の液晶表示装置における液晶層内を説明する模式図である。

【図 7】(a) ~ (h)、(a') ~ (h') は本発明の第 1 の実施の形態の製造工程を示す断面図である。

10

【図 8】本発明の第 3 の実施の形態の構成を示す平面図である。

【図 9】図 8 の A - A' 線の断面図である。

【図 10】本発明の参考例の構成を示す平面図である。

【図 11】図 10 の B - B' 線の断面図である。

【図 12】従来例 1 の構成を示す平面図である。

【図 13】図 12 の A - A' 線の断面図である。

【図 14】従来例 2 の構成を示す平面図である。

【図 15】図 14 の A - A' 線の断面図である。

【図 16】(a) ~ (h) は従来例 2 の製造工程を示す断面図である。

【図 17】基板に垂直な電界で液晶を駆動する液晶表示装置を示す平面図である。

20

【図 18】図 17 の A - A' 線の断面図である。

【符号の説明】

1、2 基板

3 走査線

3 a ゲート電極

4 ゲート絶縁膜

5 半導体層

6 n 型半導体層

7 信号線

7 a ソース電極

7 b ドレイン電極

8 パッシベーション膜

9 R、9 G、9 B カラーフィルタ

10 オーバーコート層

11 画素電極

12 COM 電極

13 液晶層

14 共通電極線

15 遮光層

20 遮光層

21 絶縁膜

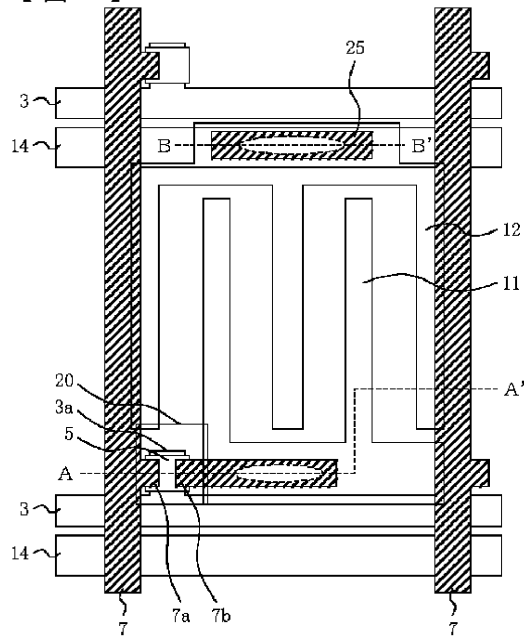
25 導通部

200 液晶分子

30

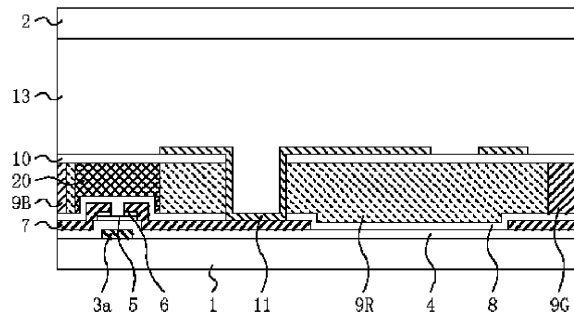
40

【図 1】



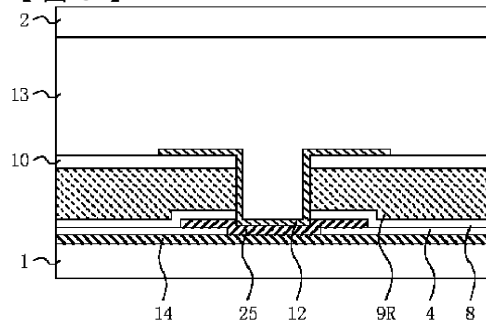
3: 走査線, 7: 信号線, 7a: ソース電極
7b: ドレイン電極, 11: 画素電極, 12: COM電極
14: 共通電極線, 25: 導通部

【図 2】

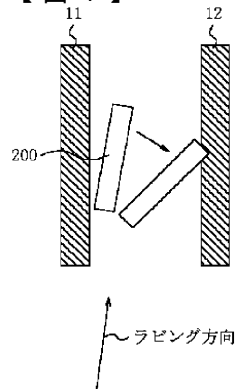


1: TFT基板, 2: 対向基板, 3a: ゲート電極
4: ゲート絶縁膜, 5: 半導体層, 6: n型半導体層
8: パッシベーション膜, 9R, 9G, 9B: カラーフィルタ
10: オーバーコート層, 11: 画素電極
13: 液晶層, 20: 遮光層

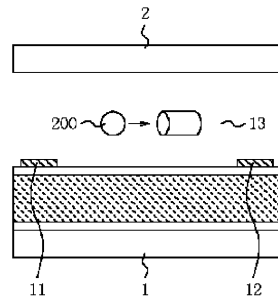
【図 3】



【図 4】



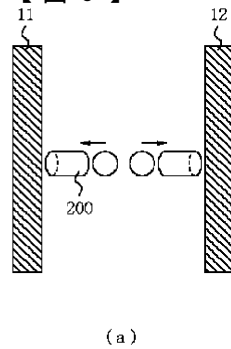
(a)



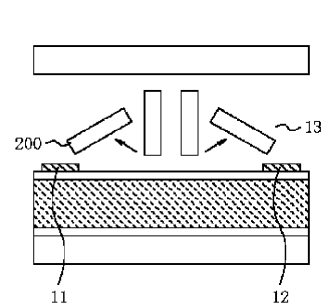
(b)

200: 液晶分子

【図 6】

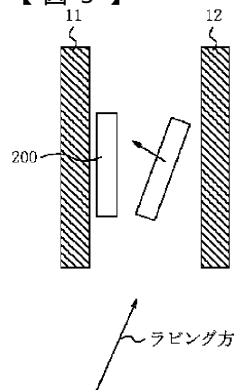


(a)

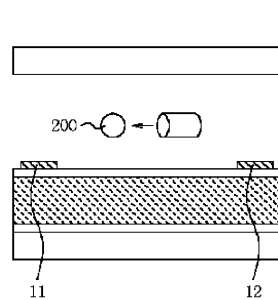


(b)

【図 5】



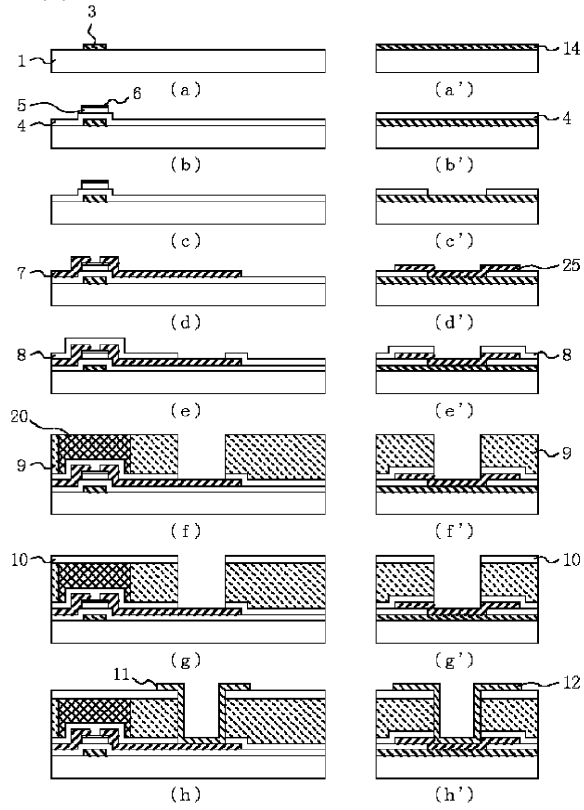
(a)



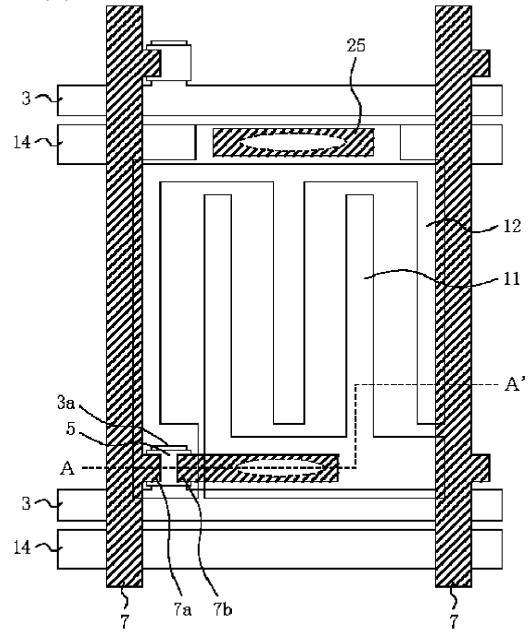
(b)

200: 液晶分子

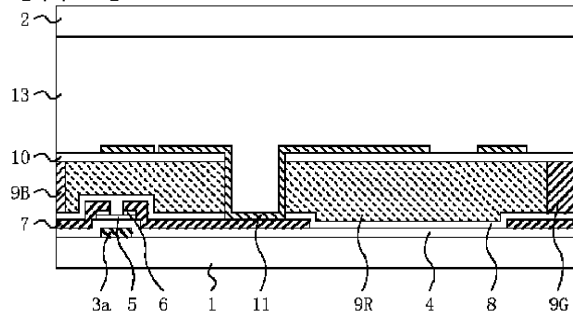
【 図 7 】



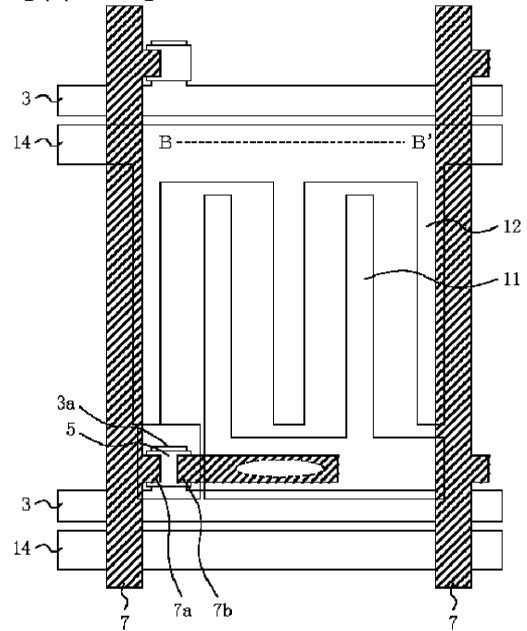
【 図 8 】



【 図 9 】



【 図 1 0 】



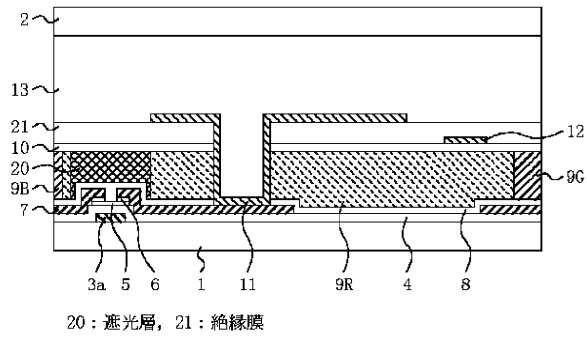
A cross-sectional view of a multi-layered structure. The layers are labeled on the left and right sides. On the left, labels 1, 2, 4, 8, 10, 13, and 14 are positioned next to horizontal lines. On the right, labels 1, 2, 4, 8, 10, 13, and 14 are positioned next to horizontal lines. The structure consists of several layers: a top layer (1), a layer with diagonal hatching (2), a layer with a cross-hatch pattern (4), a layer with a dotted pattern (8), a layer with a diagonal hatching pattern (9R), a layer with a cross-hatch pattern (10), a layer with a dotted pattern (13), and a bottom layer (14).

3: 走査線, 3a: ゲート電極線, 5: 半導体層
7: 信号線, 7a: ソース電極, 7b: ドレイン電極
11: 画素電極, 12: COM電極, 14: 共通電極線

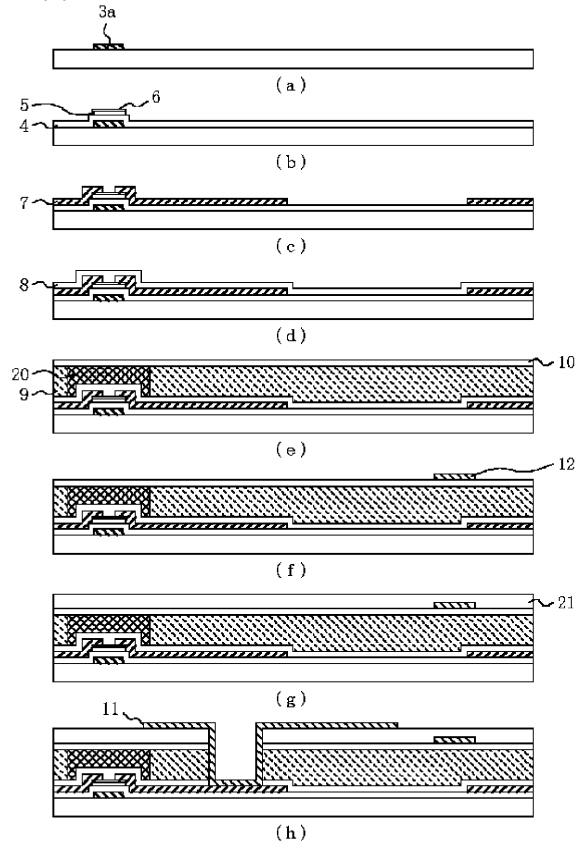
[illegible]

1: TFT基板, 2: 対向基板, 4: ゲート絶縁膜
6: n型半導体層, 8: パッシベーション膜
9: カラーフィルタ, 10: オーバーコート層
13: 液晶層, 15: 遮光層

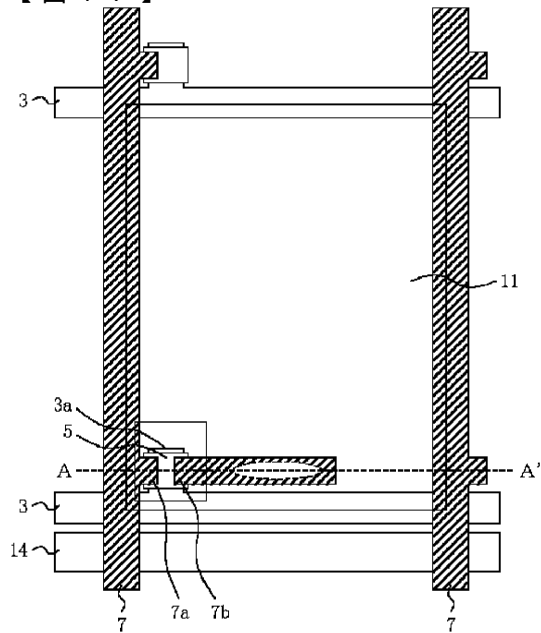
【図 15】



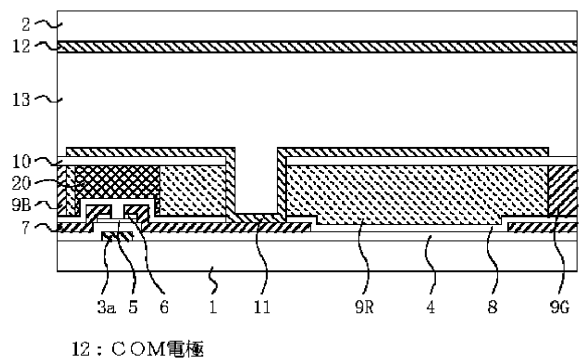
【図 16】



【図 17】



【図 18】



フロントページの続き

(72)発明者	渡邊 貴彦	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	岡本 守	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	中田 慎一	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	山本 勇司	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	鈴木 成嘉	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	鈴木 照晃	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	石井 俊也	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内
(72)発明者	加納 博司	
	東京都港区芝五丁目7番1号	日本電気株式会社内

審査官 右田 昌士

(56)参考文献 特開平11-119237(JP,A)
 特開平11-133408(JP,A)
 特開平11-119252(JP,A)
 特開平09-230380(JP,A)
 特開平10-268287(JP,A)
 特開平10-186351(JP,A)
 特開平06-160878(JP,A)
 特開平04-096017(JP,A)
 特開平10-288796(JP,A)
 特開平10-301141(JP,A)
 特開平07-128683(JP,A)
 特開平10-135480(JP,A)
 特開2000-292801(JP,A)
 特開平08-334748(JP,A)
 特開平11-190856(JP,A)
 特開2001-051288(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl.⁷, DB名)

G02F 1/1368
 G02F 1/1333
 G02F 1/1335
 G02F 1/1343

专利名称(译)	液晶显示装置的制造方法		
公开(公告)号	JP3721156B2	公开(公告)日	2005-11-30
申请号	JP2002321161	申请日	2002-11-05
申请(专利权)人(译)	NEC公司		
当前申请(专利权)人(译)	NEC LCD科技有限公司		
[标]发明人	吉川周憲 坂本道昭 渡邊貴彦 岡本守 中田慎一 山本勇司 鈴木成嘉 鈴木照晃 石井俊也 加納博司		
发明人	吉川 周憲 坂本 道昭 渡邊 貴彦 岡本 守 中田 慎一 山本 勇司 鈴木 成嘉 鈴木 照晃 石井 俊也 加納 博司		
IPC分类号	G02F1/1335 G02F1/1333 G02F1/1343 G02F1/1368		
FI分类号	G02F1/1368 G02F1/1333.505 G02F1/1335.500 G02F1/1335.505 G02F1/1343		
F-TERM分类号	2H090/HA04 2H090/HB13 2H090/HB13Y 2H090/HD02 2H090/KA04 2H090/LA01 2H090/LA04 2H090/LA15 2H090/MA01 2H090/MA02 2H090/MA15 2H091/FA02Y 2H091/FA34Y 2H091/GA06 2H091/GA13 2H091/GA16 2H091/LA12 2H091/LA19 2H092/GA14 2H092/GA29 2H092/HA28 2H092/JA24 2H092/JA26 2H092/JA41 2H092/JA46 2H092/JB58 2H092/KB26 2H092/MA13 2H092/NA01 2H092/NA27 2H092/NA29 2H092/PA02 2H092/PA08 2H190/HA04 2H190/HD02 2H190/KA04 2H190/LA01 2H190/LA04 2H190/LA15 2H190/LA22 2H190/LA23 2H190/LA25 2H191/FA02Y 2H191/FA13Y 2H191/GA08 2H191/GA19 2H191/GA22 2H191/LA13 2H191/LA25 2H192/AA24 2H192/BB03 2H192/BB73 2H192/BC31 2H192/CB05 2H192/EA04 2H192/EA13 2H192/EA42 2H192/EA56 2H192/EA67 2H192/GA31 2H192/GA42 2H192/JA33 2H192/JA34 2H291/FA02Y 2H291/FA13Y 2H291/GA08 2H291/GA19 2H291/GA22 2H291/LA13 2H291/LA25		
代理人(译)	台正彦 工藤志 谷泽恭久		
其他公开文献	JP2003177429A		
外部链接	Espacenet		
摘要(译)			

要解决的问题：在不增加制造工艺数量的情况下，以高产率获得不具有显示不均匀性的液晶显示板。解决方案：扫描线，栅电极3a，信号线7和薄膜晶体管形成在第一透明基板上，滤色器9R，9G和9B设置在包含它们的整体的上层。在滤色器层上形成外涂层10，并且在上涂层上将像素电极11和COM电极设置在同一层中。该TFT基板和第二透明基板彼此相对，并且液晶13插入其间。Z

